

A - 7 次の記述は、MOS形FET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

- 1 電流駆動のバイポーラトランジスタと比べ、MOS形FETは電圧駆動のため駆動損失が小さく高周波動作に適している。
- 2 MOS形FETは静電気に強い構造であるため、単体で保管する場合でも特別な措置は必要ない。
- 3 MOS形FETには、Nチャネル形とPチャネル形があるが、使用されるMOS形FETの大半はNチャネル形である。
- 4 比較的大きな電力を扱うものは、一般にパワーMOSFETとも呼ばれ、送信機の電力増幅部や電源装置などに使用されている。
- 5 パワーMOSFETの並列接続は、発振防止やスイッチング時間の整合などの注意が必要であるが、バイポーラトランジスタと比べると比較的容易に並列運転ができる。

